

영자왜 아몰퍼스 자성박막의 인덕턴스 효과

Inducdance Effects of Zeromagnetostrictive Amorphous Magnetic Films.

서 강 수 生산기술연구원 산업기술교육센터

임 재 균 극동전문대학 전자통신과

정 승 우 명지대학교 공과대학 대학원 전자공학과

신 용 진 명지대학교 공과대학 전기전자공학부

Kang-Soo Seo Korea Institute of Industrial Technology, Training Center

Jae-Keun Lim Dept. of Electronic Telecommunication, Keuk-dong College

Seung-Woo Chong Dept. of Electronic Engineering, Myong-ji University

Yong-Jin Shin Dept. of Electric & Electronic Engineering, Myong-ji University

Abstract

In this paper, we inveatigate frequency dependance of inductance effects of FeCoB amorphous magnetic films.

First, amorphous magnetic film having near zero magnetostriction is the basic composition of $(Fe_{1-x}Co_x)_{79}Si_2B_{19}$ with $x=0.94, 0.95$ and in order to decrease magnetio-anisotropy, the film was annealed in $280^{\circ}C/30min, 400^{\circ}C/30min, 400^{\circ}C/1hr$ with near crystallization temperature under non-magnetic field.

As result of investigation, in case of $x=0.95$ than $x=0.94$, we could have obtained high values, which inductance ratios in the low frequency was 488%. And Quality factor Q was under 0.7 in all sample, in case of annealed in $280^{\circ}C/30min$, we could have obtained highest value, which $x=0.94$ is about 0.62 in $400[kHz]$, and in case of $x=0.95$ was about 0.35 in $1[MHz]$.

I. 서 론

자성박막은 1955년 Blois가 Fe-Ni 증착막이 컴퓨터 메모리분야에 유용하다고 제안한 이래, 많은 연구자로부터 연구가 진행되어 왔는데, 그 대다수가 Fe-Ni를 주로한 페르로이에 관한 것이었다¹⁾.

아몰퍼스 금속은 고강인, 고경도 및 저탄성이면서, 전기저항률이 높고, 결정자기이방성이 존재하지

않는 고투자율의 연자성재료이며, 저질손이고, 자왜가 현저하다는 등의 여러 가지 특성을 가지고 있어서, 메모리 재료, 트랜스 재료 및 고성능 자기헤드 등의 응용연구가 활발히 진행되어 그 일부가 이미 실용화되어 있다.^{1,2)}

그리고, 부자왜를 갖는 Co-Si-B 아몰퍼스 와이어는 뱀브(bamb)상의 자구모양을 나타내고, 큰 원주방향 자화성분을 갖기 때문에 통전에 의하여 미

약한 원주 방향 자계의 인가로도 큰 변화율을 갖는 미소 인덕턴스 소자로서 이용된다. 최근 Kawazima 등은 영자왜에 가까운 조성의 아몰퍼스 와이어의 MI 효과를 이용한 소자로서 자기센서를 보고한 바 있다.^{2,3)}

본 연구에서는 위치제어를 위한 정밀계측 자기센서 개발을 위하여 영자왜재료에 가까운 $(Fe_{0.06}Co_{0.94})_{79}Si_{2.0}B_{19.0}$ 와 $(Fe_{0.06}Co_{0.94})_{79}Si_{2.0}B_{19.0}$ 의 아몰퍼스 박막을 제작하고, 열처리를 행한 후, 그 자기·인덕턴스효과를 조사하고, 센서소자로서의 가능성 을 확인하였다.

II. 실험방법

아몰퍼스 박막은 마그네트론 스파터링장치(ANELVA, SPF-332H)를 사용하여 제작하였다.

스파터링할 때의 주파수는 13.56[MHz]이었고, 챔버내의 가스는 고순도의 Ar가스(순도 99.995%)를 사용하였다. 그리고, 타겟의 조성은 직경이 10cm인 순도 99.9% Co판과 Fe, Si 및 B을 소편으로 구성하고, 기본조성식은 $(Fe_{1-x}Co_x)_{79}Si_{2.0}B_{19.0}$ 로 하여, 영자왜재에 가까운 $x=0.94$ 와 0.95로 하였다.

그리고, $18 \times 18[\text{mm}]$ 크기의 유리기판상에 두께 1~4 $[\mu\text{m}]$, 직경 $14[\text{mm}]$ 의 원형으로 시료를 제작하였다. 스파터링 시간은 20[min]과 30[min]으로 일정하게 하였다. 그리고 예비 스파터링은 15[min]이상, Ar가스 주입전의 챔버(chamber)의 진공도는 2×10^{-6} [Torr]이하로 하고, 입력전력은 400[W]로 하여 스파터링을 하였다.^{4,5)}

그리고, 박막제작시 내부에 가해지는 응력을 완화하고, 또, 이방성의 저감을 위해서, 결정화온도(360°C)의 부근인 280°C 와 400°C 에서 열처리를 행하였으며, 인덕턴스는 박막시료에 전류 $i=1[\text{mA}]$ 를 통전하고, RF LCR(HP-4276, 100Hz~1MHz, HP-4286A, 1GHz)를 이용하여 주파수에 따른 인덕턴스의 변화를 측정하였다. 그림 1은 박막의 자화곡선 측정회로의 개략도를 나타낸 것이다.

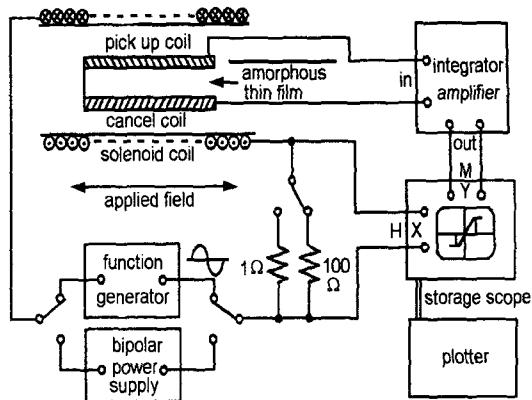


Fig. 1 Measuring circuit of magnetization curve.

III. 실험 및 결과

그림 2는 열처리하지 않은 $(Fe_{0.06}Co_{0.94})_{79}Si_{2}B_{19}$ 와 $(Fe_{0.05}Co_{0.95})_{79}Si_{2}B_{19}$ 의 자화곡선이다. 그림으로부터 알 수 있는 바와 같이, Co양의 증가에 따라 부의 자왜가 크게 되어, 이방성이 증가하기 때문에 포화에 요하는 자계가 $(Fe_{0.06}Co_{0.94})_{79}Si_{2}B_{19}$ 의 시료보다 크게 됨을 알 수 있다.

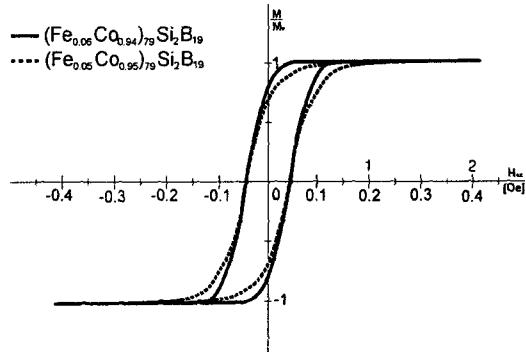


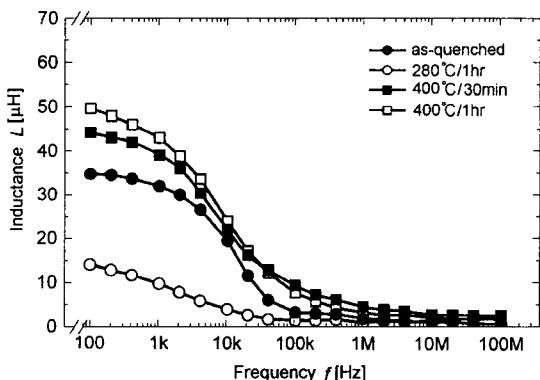
Fig. 2 Magnetization curve.

그림 3은 시료박막의 인덕턴스의 주파수특성을 나타낸 것이고, 표 1은 주파수 100[Hz]에서 측정한 박막의 인덕턴스 L 의 값이다. Takajo 등의 보고에 의하면⁶⁾, 280°C 에서 열처리한 시료는 메이즈 자구패턴을 보이고 있기 때문에 정자왜를 갖는 것으로 판단

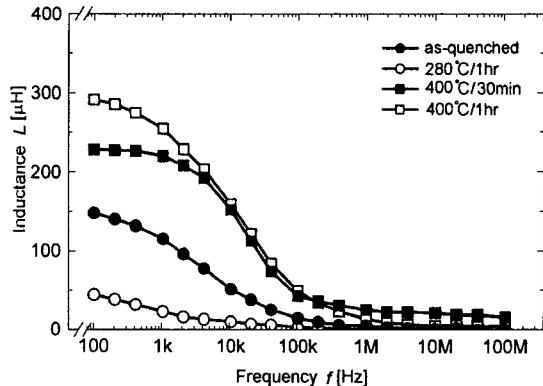
되며, 결정화 온도(360°C)이상에서 열처리하면, 박막 내에 잔류하는 응력이 완화되기 때문에 이방성이 감소하고, 메이즈상의 자구패턴이 무너져 가기 때문인 것으로 추정된다. 또, 큰 인덕턴스 L 은 열처리에 의한 이방성 뿐만 아니라, 자구구조에도 영향을 받게 되므로, 그림 2에 나타난 바와 같이 $x=0.95$ 의 시료가 이방성이 큰데도, 열처리에 의하여 이방성 저감과 자구패턴의 변화에 의하여 큰 인덕턴스 L 을 나타내었다. 이것은 Takajo 등의 보고와도 일치하고 있다⁶⁾.

Table. 1 Measuring data of inductance.

Freq. Sample Temp.	100[kHz]	
	$x=0.94$	$x=0.95$
as-quenched	34.8[μH]	148.5[μH]
280°C/30min	14.1[μH] (40.5%)	44.6[μH] (30%)
400°C/30min	49.7[μH] (143%)	292.1[μH] (197%)
400°C/1hr	44.3[μH] (127%)	229.1[μH] (154%)



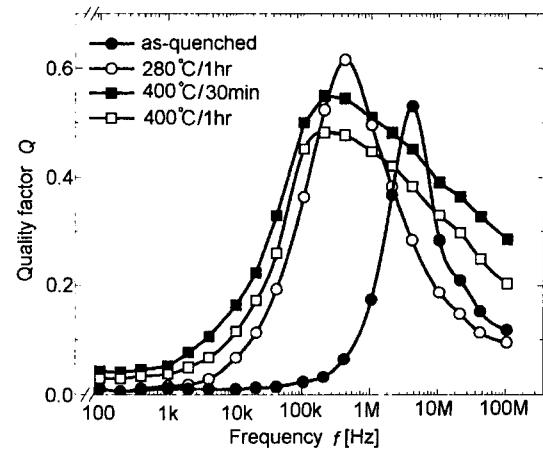
(a) $x=0.94$



(b) $x=0.95$

Fig. 3 Frequency dependence of inductance.

그림 4는 양질도 Q 의 주파수의존성을 나타낸 것이다. 모든 시료의 Q 값은 0.7이하로서, 280°C에서 30분간 열처리한 경우 $x=0.94$ 인 경우는 400[kHz]에서 약 0.62로 가장 큰 값을 갖지만, $x=0.95$ 인 경우는 1[MHz]에서 약 0.35를 나타내고 있다. 이는 $x=0.94$ 보다 $x=0.95$ 가 열처리에 의하여 자기이방성의 저감과 자기저항의 증가에 의한 것으로 생각된다.



(a) $x=0.94$

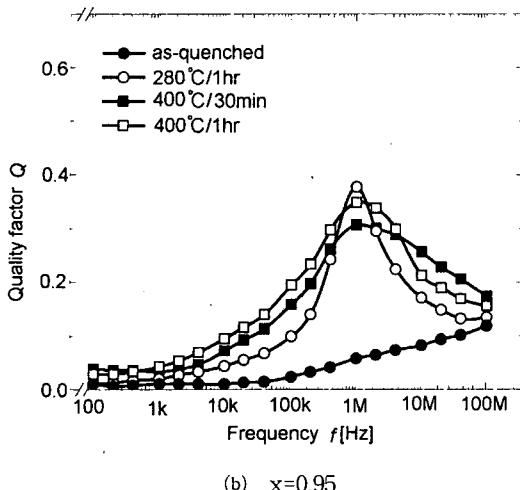


Fig. 4 Frequency dependence of quality factor Q .

IV. 결 론

이상과 같이, 아몰퍼스 자성박막을 제작하여 그 자기특성과 주파수에 따른 인덕턴스의 변화에 대하여 조사한 결과를 정리하면, 다음과 같다.

- 1) 열처리를 하지 않은 $x=0.94$ 와 0.95 시료의 인덕턴스 L 은 $100[\text{Hz}]$ 에서 각각 34.8 , $148.5[\mu\text{H}]$ 이었으며, 280°C 에서 열처리한 박막에서는 각각 14.1 , $44[\mu\text{H}]$ 로서, 각각 약 60% , 40.5% 로 저하하였고, 400°C 에서 열처리한 박막에서는 각각 49.7 , $292.1[\mu\text{H}]$ 로서 각각 약 143 , 197% 의 증가율을 얻었다.

- 2) $400^\circ\text{C}/30\text{min}$ 로 열처리했을 때, $x=0.95$ 인 경우는 $x=0.94$ 인 경우보다 인덕턴스의 변화율이 488% 로 개선됨을 알 수 있었다.
- 3) 시료의 Q 값은 모두 0.7 이하로서, 280°C 에서 30 분간 열처리한 경우 $x=0.94$ 인 경우는 $400[\text{kHz}]$ 에서 약 0.62 의 값을 갖지만, $x=0.95$ 인 경우는 $1[\text{MHz}]$ 에서 약 0.35 를 나타내었다. 따라서, 영자왜 아몰퍼스 시료 자성박막이 MI소자로서의 가능성을 갖추고 있음을 확인할 수 있었다.

참 고 문 헌

- 1) 鶴岡 誠外 2人 ; "高飽和磁束密度Co-Zr-Pd及びCo-Hf-Pd系アモルファス膜の磁氣特性", 日本應用磁氣學會誌, 11, (2) 307 (1987)
- 2) 竹澤昌晃 外 6人 ; "LC共振を利用した高感度薄膜磁氣センサの可能性", 日本應用磁氣學會誌, 21, 661 (1997)
- 3) 川島, 光澤, 吉田, 毛利, L.V.Panina ; "アモルファス磁性ワイヤの磁氣インダクタンス効果と MI 素子", 日本應用磁氣學會誌, 17, 423 (1993)
- 4) 山下慎次, 山崎二郎, 池田滿召, 岩瀬憲昭 ; "Nd-Fe-Bスマッタリング異方性薄膜磁石", 日本應用磁氣學會誌, 15, (2), 241 (1991)
- 5) K.Mohri ; "Re-entrant Magnetic Flux Reversal in Amorphous Wires", IEEE Trans. Magn., MAG-20, 942 (1984)
- 6) 高城 實, 山崎二郎, 小笠原 勇, 八木正昭 : "アモルファスワイヤの通電によるインダクタンスの高周波特性", 日本應用磁氣學會誌, 18, (2) 469 (1994)